技術展望・技術解説

アルミニウムの腐食のおはなし その9*

島田 隆登志**, 兒島 洋一**

The Fundamentals of Corrosion of Aluminum IX*

Takatoshi Shimada** and Yoichi Kojima**

Keywords: aluminum alloy, electrochemical impedance spectroscopy, interface, corrosion

1. はじめに

腐食はアノードおよびカソードとして働く電極対(材 料)と電解質(環境)との界面における電気化学反応に より進行する。アルミニウム材料は1000系の純アルミ ニウム系合金からAl-Fe系合金およびLi添加合金など の8000系合金まで数多く存在し、これらのアルミニウ ム合金は種々の金属間化合物およびマトリクスによっ て構成されている。金属間化合物およびマトリクスは, 構成元素およびその濃度などに依存してそれぞれに異 なる電気化学的特性を示す¹⁾。このため, 電極対(材料) は様々である。一方,アルミニウム材料は,輸送機器, 建築物、エレクトロニクス製品など幅広い分野で使用 されるため, 電解質 (環境) もまた様々である²⁾。これ らの電極対と電解質との組合せで構成される界面はさ らに様々となる。Wolfgang Pauli博士による「固体は神 が創造し、表面は悪魔が創造した。」との名言になぞら えると、「二つの相の表面が相互作用する界面は大魔が 創造した。」とでもなろうか。電気化学測定はこの大魔 に立ち向かわんがための矛となるが、なかでも鋭利な のが電気化学インピーダンス法である。これを手に大 魔を御し、大魔をして大神への変貌を遂げしむれば Herbert Kromer博士の「界面こそがデバイス。」との境 地の片鱗を電気化学的に伺うことができるやも知れな い。話の飛躍が過ぎたが、交流を用いる電気化学イン ピーダンス法から得られるデータの見た目は他の電気 化学測定とは大きく異なり、呪文の如く不可解な様相 をしている。こうしたことが、測定を始めようとする

段階での敷居を高くしているとも思われる。本稿では、 電気化学インピーダンス法について、アルミニウム材 料の腐食解析に適用した例を紹介し、直感的にご理解頂 けるよう心掛けて解説させて頂く。なお、本稿は Furukawa-Sky Review No. 2~9に連載してきた'アルミ ニウムの腐食のおはなし その1~8'の続編に相当する。

2. 電気化学測定法

2.1 定常測定法と非定常測定法

電気化学測定法は数多くあり^{3)~7)},一般に定常測定 法と非定常測定法に大別される。ただし、ほとんどの 腐食反応は電極上で異なる化学種の生成あるいは消費 を伴うため、電流 (I) および電位 (E) は時間 (t) の関数 となり、厳密な意味での定常状態は存在しない。その ため、定常測定法では準定常状態におけるIおよびEを 測定していることになる。定電位法, 定電流法, 電位 走査法(掃引速度が0.1 V min⁻¹以下)などは、定常測定 法に相当し、IとEとはオームの法則により抵抗(R)で 結び付けられる。系が準定常状態に達している、即ち、 電気二重層の充電や皮膜の成長などが完了した状態に おいて, Rは溶液抵抗, 電荷移動抵抗, 酸化物皮膜の 抵抗などを内包するため、定常測定法で各抵抗値を分 離して測定することは難しい。そこで、各種の非定常 測定法が開発された。非定常測定法には、ボルタンメ トリー, 定電位ステップ法, 電気化学インピーダンス 法 (electrochemical impedance spectroscopy, 以降 EIS) などがある。

本稿は,Furukawa-Sky Review No.2~9に連載してきた "アルミニウムの腐食のおはなし その1~8"の続編に相当する。

This report corresponds to the continuation of The Fundamentals of Corrosion of Aluminum I-VIII in Furukawa-Sky Review No. 2-9. ** (株) UACJ 技術開発研究所 深谷センター 第二部

No. 2 Department, Fukaya Center, Research & Development Division, UACJ Corporation

2.2 EIS 測定装置

EISは非定常測定法の中でも広範囲の周波数(f)を利 用することが可能であり、複雑な界面現象の諸要因を 分離して測定できるため、汎用性が高い。周波数応答 解析装置 (frequency response analyzer, 以降 FRA)の 登場により、他の一般的な電気化学測定同様、EISは 簡便に実施できるようになっている。EISは1940年頃 に確立された手法⁸⁾であり、1970年代にSolartron社や Applied Princeton Research社から全自動電気化学イ ンピーダンス測定装置が販売され始め、以降、急速に 普及した⁹⁾。こうした時期からEISは、液相での拡散過 程および界面での化学反応に対応する理論構築,また, 多孔質電極の解析等に用いる手法として一般化し、耐 食性評価, 電析プロセスの評価, 各種センサの性能評 価、電池などエネルギー変換デバイスの性能評価、誘 電材料の電気特性評価などの様々な分野で利用されて いる10),11)。

3. 電気化学インピーダンス法

3.1 位相差とインピーダンス

EISでは*E*または*I*の交流信号を電極に与え,*I*と*E* との比より伝達関数であるインピーダンスまたはアド ミッタンスを求める。コンデンサに(1)式の正弦波交 流電圧*V*(*t*)を入力した際の電流応答を**Fig.1**に示す。

$$V(t) = V_0 \sin \omega t \tag{1}$$

ここで、 V_0 は振幅、 ω は角周波数であり、 $2\pi f(f$ は周 波数)で表され、電流応答I(t)は次式で表される (Fig. 1)。

$$I(t) = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{2}$$



Fig. 1 Relationship between the applied sine wave AC voltage, V(t), and the current response, I(t).

ここで, I_0 は振幅である。コンデンサの場合, $I \downarrow V \downarrow$ りも $\frac{\pi}{2}$ 進むことがわかる。一方, コンデンサに蓄え られる電気量 (Q) と静電容量 (C) との間に

$$Q = CV \tag{3}$$

が成立し,

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

で表されるため,

$$I(t) = C \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \tag{5}$$

$$C = \frac{I_0 \sin\left[\omega t + \frac{\pi}{2}\right]}{V_0 \,\omega \sin\omega t} \tag{6}$$

となり、 $I_0 \ge V_0 \ge 0$ 比 (インピーダンスの絶対値 (|Z|)、 あるいはアドミッタンスの絶対値 (|Y|)より*C*を求める ことができる。同様にコイルを考えた場合、*I*は*V*より も $\frac{\pi}{2}$ 遅れ、|Z|よりインダクタンス(*L*)が求められる。 つまり、回路は位相差とインピーダンスにより特徴づ けられる。回路が複雑になった場合でも、(1)および(2) 式で示すような時間の関数から|Z|を求めることは可能 であるが、数式および波形は複雑となり、Fig.1で出来 たはずの直感的な理解が難しくなる。そのために、EIS ではインピーダンス(*Z*)を一般に複素数で表示する。

$$Z = Z_{\rm Re} - j Z_{\rm Im} \tag{7}$$

ここで、 Z_{Re} および Z_{Im} はそれぞれインピーダンスの実数成分および虚数成分であり、jは虚数単位である。複素数を用いることで、回路を特徴づける位相差(θ)および|Z|は次式で簡便に表される。

$$\theta = \tan^{-1} \frac{Z_{\rm Im}}{Z_{\rm Re}} \tag{8}$$

$$|Z| = (Z_{\text{Re}}^2 + Z_{\text{Im}}^2)^{\frac{1}{2}}$$
(9)

3.2 Nyquist線図とBode線図

測定されたインピーダンスの表示方法として, Fig. 2

に示すNyquist線図やBode線図が主に使用される。 Nyquist線図では、インピーダンスの実数成分を横軸 に、虚数成分(通常負を上向きにとる)を縦軸に表示し、 電気回路の構成に応じて特徴的な軌跡が描かれる。例 えば、一つのRC並列回路では一つの半円を、二つの RC並列回路では二つの半円を示す。これにより、スペ クトルの概要を視覚的に捉えやすい。Bode線図では、 周波数の対数を横軸に、インピーダンスの絶対値の対 数および位相差を縦軸にとり、二本で一組の曲線で表 される。また、Fig. 2 (b) 中で示した特性値を容易に見 ることができ、一つの図の中での比較が容易である。 FRAによる自動測定ではNyquistおよびBode線図を ともに作成する機能を備えており、両図面を比較しな がら考察・検討すべきである¹²⁾。

3.3 Randles Cell Model

最も簡単な電極状態の模式図,等価回路,および等 価回路より得られるNyquist線図をFig.3に示す。電極 反応は単純に電極/溶液界面における電荷移動のみと する(Fig.3(a))^{11),13)}。このような電極状態の場合, Fig.3(b)に示す等価回路(Randles cell model)が用い られ,一つの抵抗に抵抗とキャパシタンスの並列回路 を直列に繋いだ回路で示される。このような等価回路 のNyquist線図は,一つの半円を示す。Randles Cell Modelは,他の複雑な電極状態を等価回路で示す際の



Fig. 2 (a) Nyquist and (b) Bode plots of an impedance spectrum obtained from parallel RC circuit.

出発点となるため重要となる。Nyquist線図における半 円の直径は、電荷移動抵抗 (R_{ct})に相当し、高周波数側 および低周波数側における虚数軸との交点のインピー ダンスはそれぞれ溶液抵抗 (R_{sol})および移動抵抗と溶液 抵抗の和 ($R_{sol}+R_{ct}$)となる。さらに、電気二重層容量 (C_{dl})は、

$$C_{\rm dl} = \frac{\varepsilon_{\rm dl} A}{d_{\rm dl}} \tag{10}$$

で現され、 ϵ_{dl} は電気二重層の誘電率であり、溶液の誘 電率で置き換えられることが多い。また、Aは電極の 表面積、 d_{dl} は電気二重層の厚みである。水溶液系の場 合、 C_{dl} は数10 μ F cm⁻²であり^{4),11),18)}、 C_{dl} は電極の実 表面積を検討するのに有効である。一方、半円の頂点 における周波数 f_{max} は、次式で与えられる。

$$\omega_{\max} = 2\pi f_{\max} = \frac{1}{R_{\rm ct}C_{\rm dl}}$$
(11)

R_{ct}C_{dl}は秒を単位とする時定数と呼ばれ,過渡現象にお ける応答速度,ここでは,コンデンサにある程度(約 36.8%)電荷が蓄えられるまでの時間を表し,RC並列回 路を特徴付ける指標となる。

3.4 皮膜のある系

金属表面上に均一な皮膜を有する電極状態の模式図, 等価回路,および等価回路より得られる典型的な Nyquist線図を**Fig. 4**に示す。このような電極状態の場 合,Fig. 3の電極に加えて,皮膜の抵抗(*R_f*)および電 気容量(*C_f*)を考慮する必要があるため,この電極状態 を表す等価回路においても,*R_fC_f*並列回路を新たに追 加する必要がある^{11),14),15)}。その場合,*R_f*および*C_f*は



Fig. 3 (a) Schematic diagram of a simple electrode,(b) equivalent circuit, and (c) Nyquist plot of a typical impedance spectrum.

次式で表され,Nyquist線図において二つの半円が観 察される。

$$R_{\rm f} = \frac{\rho_{\rm f} \, d_{\rm f}}{A} \tag{12}$$

$$C_{\rm f} = \frac{\varepsilon_{\rm f} A}{d_{\rm f}} \tag{13}$$

このようなパラメータから金属の耐食性を担う不働態 皮膜の性質を検討することは有効である。しかしなが ら、2組のRC並列回路の時定数の差が2桁以下の場合、 半円の分離が困難となり¹¹⁾, EISのみからでは電極状 態を確定できない。従って、電極状態を検討する際は 他の手法も併用した多角的な分析が必要となる。

3.5 皮膜欠陥のある系

Fig. 3およびFig. 4の電極状態を組合せた欠陥のある 皮膜を有する電極状態の模式図をFig. 5(a)に示す。こ の場合の等価回路は、欠陥内部の局所的な液性変化お



Fig. 4 (a) Schematic diagram of an electrode with a uniform oxide film, (b) equivalent circuit, and (c) Nyquist plot of a typical impedance spectrum.



Fig. 5 (a) Schematic diagram of an electrode with an oxide film having a defect, (b) equivalent circuit, and (c) Nyquist plot of a typical impedance spectrum.

よび幾何学形状により,欠陥内の溶液抵抗 (*R*_d)が新た に追加される (Fig. 5 (b))。この等価回路より得られる Nyquist線図にはFig. 4と同様,2つの半円が現れる (Fig. 5 (c))。解析についても同様で,各抵抗値および 電気容量から欠陥部の液性や反応速度を求めることが 可能である。Fig. 4での指摘の繰り返しになるが,二つ の時定数の差が2桁以下の場合は半円の分離が困難と なる。EISを用いる前に電極状態の観察等を行い,等 価回路の裏づけを取るべきである。

3.6 吸脱着反応を考慮した系

吸脱着反応を考慮した電極状態をFig.6に示す。こ の様な電極状態においては、吸着体上での反応および 吸着体上以外での反応を考える必要があり、吸着体上 での反応速度と吸着体上以外での反応速度とをそれぞ れr₁とr₂とする。簡単のために、電位変調時、電位上 昇に伴い吸着率は増加すると仮定する。 $r_1 > r_2$ で (Fig. 6(a)),吸脱着現象が電位変調に追従する場合,電位上 昇に伴い吸着体の被覆率は増加する。この場合、電位 変調の後に反応電流が増加するため、IはEよりも遅れ、 3.で述べたコイルのように振舞い、さらに、電位変調 は電極状態の変化を引き起こす。そのため、等価回路 はFig. 3にコイルと分極抵抗 (R_p) を追加した Fig. 6 (b) の回路で現され、Nyquist線図において、容量性半円 と誘導性半円とが一つずつ現れる (Fig. 6 (c))。一方, $r_1 < r_2$ の場合 (Fig. 6 (d)), 電位上昇, つまり吸着体の 被覆率が増加した後に反応電流は減少することから, I



^{Fig. 6 (a) Schematic diagram of an electrode with an adsorbent when reaction rate on the adsorbent is higher than that on a metal, (b) equivalent circuit, and (c) Nyquist plot of a typical impedance spectrum. (d) Schematic diagram of an electrode with the adsorbent when reaction rate on the adsorbent is lower than that on the metal, (e) equivalent circuit, and (f) Nyquist plot of a typical impedance spectrum.}

は*E*よりも進み,キャパシタンスのように振舞う。そ のため,等価回路はFig.6(e)で示すように表される。 この場合,得られる典型的なNyquist線図においてFig.4 およびFig.5と同様の二つの容量性半円が現れる (Fig.6(f))。

3.7 等価回路の素子

上述の等価回路で用いた三つの基本的な回路素子は, 最も見慣れている素子である。しかしながら,実際の 測定系において,電極表面には凹凸があり,晶出物や 析出物なども多数存在し,環境もまた試料全面に渡っ て同じ状態が保たれているとは言い難い。つまり,電 極状態を上述の基本的な回路素子のみで表現すること は困難であり,主にコンデンサの代替として使用され る不均一性を表す constant phase element (CPE)や拡 散を表す Warburg インピーダンスなどを用いて,イン ピーダンス解析は行われる。

理論を御座なりにして些か性急ではあるが,手法に 馴染んで頂くために,次章では実際にアルミニウム合 金の腐食系にEISを適用した場合に得られるスペクト ル例に進ませて頂く。用いた等価回路は,電極状態お よび界面反応を熟考した上で,その物理的意味への変 換を模索して決定されていることにご注意頂きたい。 なお,理論については,数多くの優れた著書や文献が あるので参考にされたい^{8)~11),16)~20)}。

4. アルミニウム合金への適用

4.1 溶解反応の解析

1 mol dm³ H₂SO₄水溶液中, -280 mV (SHE) に分極 されたアルミニウム合金の典型的なNyquist線図を **Fig. 7**に示す²¹⁾。Fig. 7において,二つの容量性半円と 一つの誘導性半円が観察される。類似の測定系におい て,これまでに以下のことが検討されている。

高周波数の容量性半円について,

- ・電気容量の逆数と電極電位とは直線関係にある^{22).23)}。
- 中間周波数の誘導性半円について,
- ・裸の金属上では、誘導性半円は観測されず^{24),25)},
- ·K₂SO₄, NaNO₃, およびHNO₃溶液中において誘導
 性半円は観測されない²³⁾。

低周波数の容量性半円について、

・より貴な電極電位あるいは塩化物水溶液中において, 容量性半円はWarburgインピーダンスになる²⁶⁾。

これらは, Fig.7で測定されたインピーダンスにおい

て、アルミニウム合金上に形成された酸化物皮膜およ

び酸化物皮膜/溶液界面におけるイオンの吸着が関与 することを示唆する。これらの検討および界面反 応^{27)~30)}を基に, Fig. 8 (a) に示すような電極状態を推 察する。金属表面上に酸化物皮膜が形成されており, 酸化物皮膜/溶液界面において、電気二重層が形成さ れる。さらに,酸化物皮膜/溶液界面において,イオ ンの吸着が起こり、この吸着が誘導性半円の形成に寄 与するものと考える。ここで、各界面(金属/酸化物皮 膜および酸化物皮膜/溶液界面)における反応は非常に 速く、各界面において擬似平衡が成立していると仮定 する。インピーダンス測定中, 電極状態には経時的不 変性が求められるため^{9),11)},つまり,測定中に電極状 態が変化するとインピーダンスの意味が理解できなく なるため、擬似平衡は重要な仮定である。また、金属 /酸化物皮膜界面における電位を一定と仮定すると²¹⁾, 酸化物皮膜/溶液界面と酸化物自身のみがインピーダ ンスに寄与することになる。この電極状態の等価回路 は、Fig. 4とFig. 6とを組合せたものになり(Fig. 8(b)), 酸化物皮膜はRC並列回路で表され、酸化物皮膜/溶液 界面は、電気二重層によるRC並列回路とイオンの吸着 によるLC直列回路と並列した回路で表される。Fig. 7 で示した条件下では,吸着イオンにO²を考えているが,



Fig. 7 Typical Nyquist plot of a passive aluminum under potential control at - 280 mV (SHE) in 1 mol dm³ H₂SO₄.



Cation or Anion Electric double layer Adsorbents

Fig. 8 (a) Schematic diagram of a passive aluminum electrode in solutions without aggressive anions which cause pitting corrosion. (b) Equivalent circuit. 他の溶液では,他のイオン(特にアニオン)の吸着を考 慮することが可能であり,また,吸着イオンを一つに 限る必要もない²¹⁾。このようにして数多くの知見と理 論から導き出された電極状態(等価回路)を用いて,ア ルミニウムの溶解反応における電極電位や溶液 pHの影 響を説明することができる²¹⁾。

4.2 孔食反応の解析

0.5 mol dm³のNaCl溶液中, -1140, -960および -940 mV (SHE) に分極された純アルミニウムの Nyquist線図を**Fig.** 9に示す³¹⁾。-1140 mVは不働態 域, -960および-940 mV (SHE) は孔食域である。ま た, 孔食域の電気化学インピーダンス測定では, 電極 状態が時間に依存しないようにするため, 表面全体に 孔食が発生するまで (>5 h) 分極してから実施してい る。不働態域におけるNyquist線図において, 4.1節と 同様, 二つの容量性半円および一つの誘導性半円が観 察される。一方, 孔食域において, 容量性半円および 誘導性半円が一つずつ観察される。この容量性および 誘導性半円は電位が貴になるにつれて小さくなる。

孔食は不働態皮膜に存在する欠陥より生じ,この欠陥 は,不純物(晶出物および析出物)³²⁾,金属内の空孔³³⁾, あるいは電位印加時に生じる電気歪³⁴⁾によりもたらさ れる。不働態域であれば,こうした欠陥は吸着した OHと反応し速やかに修復されるが,孔食域では,OH と競争吸着するCIが,速やかな皮膜欠陥の修復を阻害 するため,孔が成長する³⁵⁾。孔内部において,アルミ ニウム/溶液界面で(14)式の反応により塩化物層が形 成され,塩化物内層と外層とでは(15)および(16)式の 反応が生じる³⁶⁾。

$$Al + 3Cl^{-} \rightarrow AlCl_{3} + 3e \tag{14}$$

$$AlCl_3 + 6H_2O \rightarrow AlCl_3 \cdot 6H_2O$$
 (15)



Fig. 9 Nyquist plot of an aluminum under potential control at (a) - 1140 mV (SHE) in passive region and (b) - 960 and - 940 mV (SHE) in pitting region in 0.5 mol dm³ NaCl.

$$AlCl_3 \cdot 6H_2O \rightarrow Al^{3+}_{aq} + 3Cl^-_{aq}$$
(16)

一方,孔食の進展に伴い水素発生反応も起こる37)。

$$2\mathrm{H}^{+} + 2 \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{H}_{2} \tag{17}$$

これらの反応を基に考えた電極状態を**Fig. 10** (a) に示 す。前節では,金属上に酸化物皮膜が形成されている ことを想定したが,試料全面に孔食が発生しているこ とから,試料全面に塩化物層が形成されていると想定 する。これにより等価回路は,Fig. 10 (b) に示された 回路になるものと考えられる。しかしながら,Fig. 9(b) において観察された容量性半円は一つであるので,塩 化物層および電気二重層の両方で形成される容量性半 円を区別するには至らず,実験結果にフィッティング した際に得られる電気容量 $C_{\rm T}$ は二つの電気容量を包括 する。

$$\frac{1}{C_{\rm T}} = \frac{1}{C_{\rm dl}} + \frac{1}{C_{\rm sf}}$$
(18)

ここで、 C_{sf} は塩化物層の電気容量である。 C_{T} は電位の 貴化とともに減少することから、電位の貴化とともに 塩化物層は厚くなると推察される。一方、誘導性半円 は (17) 式の水素発生反応³⁸⁾および吸着中間体³¹⁾による ものと考えられるが、塩化物層の性質 (密度、イオン伝 導率、厚さなど)の変調³¹⁾なども考えられ、結論は得 られていない。この他にも孔食成長反応モデルは提案 されており^{39),40)}、いずれのモデルが妥当であるかは EISによる検証で今後、明らかになるかもしれない。

4.3 大気腐食の評価

海浜地域に6ヶ月および12ヶ月曝露した1060アルミ ニウム合金を0.1 mol dm⁻³ Na₂SO₄水溶液に浸漬した際 のBode線図を**Fig. 11**に示す²⁰⁾。比較のため、曝露し ていない1060アルミニウム合金のBode線図も併せて



Fig. 10 (a) Schematic diagram of an aluminum electrode covered by a salt film. (b) Equivalent circuit.

示す。曝露した試料の表面観察では,6ヶ月曝露の試 料表面は腐食生成物によってほぼ全面が覆われていた が、12ヶ月曝露の試料表面では、一部下地金属が見え ていた。さらに、腐食生成物を除去した後の表面には 腐食孔が見られ、12ヶ月曝露の試料表面におけるその 数は、6ヶ月曝露の試料のそれよりも多かった。これ らを基に電極状態を考える。曝露していない試料およ び曝露した試料の電極状態をそれぞれFig. 12(a)およ び(c)に示す。曝露していない試料では金属と溶液の みを想定するが、曝露した試料では金属上に形成され た自然酸化物皮膜、さらにその上に形成する腐食生成 物および孔食(欠陥)部を想定する。これらを基に選定 した等価回路がFig. 12(b) および(d) であり, Fig. 12(d) はFig. 5の等価回路に腐食生成物層を加味したCPEco とR_{cp}の並列回路を直列で繋いだ回路で表現される。な お、電極状態が不均一であるためにCPEを使用してい る。等価回路を実験結果にフィッティングした際の回 路素子のパラメータをFig. 13に示す。CPEはキャパシ タンスの代替として用いられることが多いが、ここで は、電気容量に換算した値を示す41),42)。また、腐食速 度の逆数に比例する分極抵抗 (R_p) は、次式より求めら $h 3^{(43)} \sim 45)_{\circ}$

 $R_{\rm p} = Z_{\rm L} - Z_{\rm H} \tag{19}$



ここで、ZLおよびZHはそれぞれ低周波数 (10 mHZ) お

Fig. 11 Bode plots of corroded and exposed aluminum specimens in 0.1 mol dm⁻³ Na₂SO₄.

よび高周波数(100 kHz)におけるインピーダンスであ る。分極抵抗は6ヶ月曝露>12ヶ月曝露>比較材(曝露 未実施)の順となり,腐食速度は6ヶ月曝露<12ヶ月曝 露<比較材(曝露未実施)の順になる。曝露したサンプ ルの分極抵抗(腐食速度)は,比較材のそれよりも大き く(小さく)なり,曝露期間の増加とともに,分極抵抗(腐 食速度)は増加(減少)する。一方,腐食電位は,6ヶ月 曝露>12ヶ月曝露>比較材(曝露未実施)の順に貴であ り,分極抵抗の序列と対応した。これらの別の実験結 果より,Fig.11より得られた分極抵抗(腐食速度)の差 異は,腐食生成物の形成および曝露時間とともに被覆 率が減少したことに関係付けられる。

電荷移動抵抗 (*R*_{ct}) において,比較材の*R*_{ct}は曝露し た試料よりも大きく,曝露時間が長いほど*R*_{ct}は低下す る。これは,電荷移動プロセスが起こる面積に関連付 けられる。電荷移動プロセスが金属/溶液界面で起こ る場合,電荷移動抵抗は欠陥部の表面積に対応して変



Fig. 12 (a) Schematic diagram of a simple aluminum electrode. (b) Equivalent circuit. (c) Schematic diagram of a corrode aluminum electrode. (d) Equivalent circuit.



Fig. 13 Polarization resistance; R_{p} , charge transfer resistance; R_{ct} , solution resistance in a defect; R_{d} , resistance of corrosion product; R_{cp} , capacitance of electric double layers C_{dl} , and capacitance of an oxide film; C_{f} .

化する。つまり,曝露中に生じた腐食(孔食)により, 表面積が増大したためであり,時間とともに腐食孔が 増大していた表面観察結果と対応する。一方,欠陥部 の溶液抵抗(*R*_d)は,次式で表すことできる⁴⁶⁾。

$$R_{\rm d} = \frac{\rho_{\rm d} I_{\rm d}}{P_{\rm d} S_{\rm d}} \tag{20}$$

ここで、 ρ_d は欠陥部の溶液抵抗、 P_d は欠陥の数密度、 I_d および S_d はそれぞれ欠陥部の長さおよび底面積である。曝露時間の経過とともに R_d は低下することから、 ρ_d および I_d の低下あるいは P_d および S_d の増加に起因しているものと思われる。表面観察において、時間経過 とともに腐食部が増加していたため、いずれのパラメ ータも R_d の低下に寄与しているものと考えられる。い ずれのパラメータが主要因であるかを特定するには、 腐食部の数や形状を精査する必要がある。腐食生成物 の抵抗 R_{cp} は腐食生成物の保護性を示し、曝露時間の経 過とともに低下する。これは、表面観察で確認された ように、腐食生成物が一部剥がれ落ちたことに起因す る。一方、次式で表される C_f は、曝露時間とともに増 加する。

$$C_{\rm f} = \frac{\varepsilon_{\rm f} A_{\rm f}}{d_{\rm f}} \tag{21}$$

ここで、 ε_{f} は自然酸化物皮膜の誘電率、 A_{f} および d_{f} は それぞれ自然酸化物皮膜の面積および厚さである。従って、 C_{f} の時間依存は皮膜が薄くなったことあるいは 皮膜の特性(誘電率)変化に起因する。更なる C_{f} の詳細 な解析は、自然酸化物皮膜の特性理解へと繋がる。また、電気二重層容量 C_{dl} も曝露時間とともに増加し、 R_{d} の解析で考えられた表面積の増加に対応する。

4.4 アノード酸化皮膜の評価

0.1 mol dm³ NaOH水溶液中,アノード酸化したアル ミニウムのEIS測定より得られた電荷移動抵抗 R_{ct} の経 時変化および各時点における電極状態の模式図を**Fig.** 14に示す⁴⁷⁾。なお,アノード酸化皮膜は,25℃の0.3 mol dm³ Na₂CO₃水溶液中,2 mA cm²で定電流保持し, 電圧が71 Vに到達した後,600 s保持することにより 形成した。 R_{ct} は,浸漬直後の42.3 k Ω cm²から緩やか に減少し,約1150 sにおいて急激に減少し,その後,約100 Ω cm² でほぼ一定となる。各時間における電極 状態の観察から,電荷移動抵抗の経時変化は下記のよ うに考えられる。浸漬初期において,ポーラス層の孔



Fig. 14 Time variation of charge transfer resistance $R_{\rm ct}$ of an anodized aluminum (4 N) in 0.1 mol dm⁻³ NaOH and a schematic diagram of an anodized aluminum electrode. The anodization was performed at 2.0 mA cm⁻² until the voltage attains 71 V and then the voltage was kept for 600 s.

壁表面と底部とから急速に溶解が起こるため^{48,49}, バ リア層と溶液界面における電荷移動抵抗が支配的にな る。ポーラス層の消失とともにバリア層の均一溶解と 局部溶解とが同時に進行し,反応性の高い下地金属が 徐々に露出するため,緩やかなR_{et}の減少が起こる。バ リア層が消滅すると試料全体は反応性に富む下地Alと なるため,急激なR_{et}の減少に繋がる。その後,更なる 下地金属の均一溶解と水和酸化物皮膜の成長が起こ る。R_{et}の急激な変化は,電極電位の経時変化において も見られる。しかしながら,電極電位は,電極状態の 変化を考察することは可能であるが,溶解速度(電荷移 動抵抗)の経時変化を考察するには至らない。EISは電 極電位と電流との比であるインピーダンスを用いてい るため,電極電位から得られる電極状態と電流から得 られる溶解速度の両方を一遍に検討することができる。

4.5 電池集電体の評価

集電体にカーボンコート箔であるNEXB[®]とプレー ン箔を用いて作製したリチウムイオン電池の直流内部 抵抗と交流内部抵抗の経時変化をFig. 15に示す⁵⁰⁾。な お、リチウムイオン電池は60℃で保管され、交流内部 抵抗は100 Hzの周波数における値である。NEXBでは 保管日数に依存せず初期内部抵抗を維持し、非常に優 れたカレンダー寿命を有するのに対し、プレーン箔で は保管日数とともに増加する。一方、交流内部抵抗内 部は直流内部抵抗よりも低い。これは、直流内部抵抗 は測定端子なども含める電池内の全ての抵抗成分を含 んでいるのに対し、交流内部抵抗は接触抵抗のみを主 に反映しているためである。リチウムイオン電池は集



Fig. 15 Dependence of internal DC and AC resistance of a lithium ion battery on storage time. A plane aluminum foil and NEXB[®] was used as a current collector of both active and negative electrodes.

電体, 正極, 負極, 活物質, 導電助剤などの様々な物 質から構成されている非常に複雑なデバイスである。 そのため, 各物質の抵抗およびそれらの物質が接触す ることで形成される界面での抵抗を含むため, 直流内 部抵抗のみの評価では電池構成の更なる改良には至ら ないが, 交流内部抵抗を用いることで改良点を明らか にすることが出来るはずである。

5. おわりに

電気化学インピーダンス法は腐食反応の解析や評価 法として幅広く定着し、本稿で述べた他にも様々な電 極状態に対して、それぞれを表現した種々の等価回路 が提案されている。これら等価回路のインピーダンス スペクトルは、対応した電極状態について得られるそ れらを再現しているのはもちろんであるが、酷似した インピーダンススペクトルを異なる等価回路から得る こともできる。すなわち、スペクトルの再現は想定し た等価回路の妥当性を考察する上での必要条件でしか なく、実験データをフィッティングする際には想定で きる等価回路の自由度が大きいことに戸惑う場合がで てくる。従って、等価回路の想定にあたっては電極状 態や反応機構などを予めイメージすることが求められ, 適切にイメージするにはある程度の習熟が必要である ことは否めない。本稿では、いくつかの電極状態につ いて、対応する等価回路と得られるインピーダンスス ペクトルを非常に簡単ではあるが紹介した。電気化学 インピーダンス法を始める際の敷居をわずかでも低く させて頂けたなら望外の喜びである。

参考文献

- N. Birbilis and R.G. Buchheit : J. Elelctrochem. Soc., 152 (2005), B140-B151.
- 2) 腐食防食協会編:材料環境学入門 丸善, (1993).
- (2005).
 (2005).
- 電気化学会編:電気化学測定マニュアル 基礎編・実践編, 丸善,(2002).
- 5) 藤島 昭, 相澤益男:電気化学測定法 上·下, 技報堂, (1984).
- 7) 逢坂哲彌,小山昇:電気化学法-応用測定マニュアル-, 講談社,(1990).
- R.C. Bacon, J.J. Smith and F.M. Rugg : Industrial & Engineering Chemistry, 40 (1948), 161-167.
- F.L. Floyd, S. Avudaiappan, J. Gibson, B. Mehta, P. Smith, T. Provder and J. Escarsega : Prog. Org. Coat., 66 (2009), 8-34.
- 10) 板垣昌幸:表面化学, 33 (2012), 64-68.
- 11) 板垣昌幸:電気化学インピーダンス法 第2版, 丸善, (2011).
- 12) 水流 徹: Boshoku Gijutsu, 34 (1985), 582-583.
- N. Ekekwe : Electrochemical Impedance Spectroscopy: Corrosion Behavior Application, VDM Verlag Dr. Müller Akitiengesellschaft & Co. KG, (2009).
- 14) 板垣昌幸: Zairyo-to-Kankyo, 48 (1999), 681-685.
- Y. Liu, Z. Wang and W. Ke: Corros. Sci., 80 (2014), 169-176.
- 16) 片山英樹: J. Jpn. Soc. Colour Mater. 79 (2006), 352-357.
- 17) 杉本克久: Zairyo-to-Kankyo, 48 (1999), 673-680.
- 18) E.B. Castro and J.R. Vilche: Electrochim. Acta, 38 (1993), 1567-1572.
- 19) 水流徹,春山志郎: Boshoku Gijutsu, 28 (1978), 134-137.
- 20) D.D. Macdonald : Electrochim. Acta, 35 (1990), 1509-1525.
- 21) J.H.W. De Wit and H.J.W. Lenderink: Electrochim. Acta, 41 (1996), 1111-1119.
- 22) J. Bessone, C. Mayer, K. Jüttner and W.J. Lorenz: Electrochim. Acta, 28 (1983), 171-175.
- 23) H.J. Wit, C. Wijenberg and C. Crevecoeur: J. Electrochem. Soc., **126** (1979), 779-785.
- 24) G.T. Burstein and R.J. Cinderey: Corros. Sci., 33 (1992), 475-492.
- 25) R.J. Cinderey and G.T. Burstein: Corros. Sci., 33 (1992), 493-498.
- R. Krishnaqakumar and Z. Szklarska-Smialowska: Mater. Sci. Forum, 111-112 (1992), 565-580.
- 27) C.Y. Chao, L.F. Lin and D.D. macdonald: J. Electrochem. Soc., 128 (1981), 1187-1194.
- 28) D.D. Macdonald: J. Electrochem. Soc., 139 (1992), 3434-3449.
- 29) D.D. Macdonald, S.R. Biaggio and H. Song: J. Electrochem. Soc., 139 (1992), 170-177.
- 30) C.Y. Chao, L.F. Lin and D.D. macdonald: J. Electrochem. Soc., 129 (1982), 1874-1879.
- J.B. Bessone, D.R. Salinas, C.E. Mayer, M. Ebert and W.J. Lorenz: Electrochim. Acta, 37 (1992), 2283-2290.
- 32) 兒島洋一,本川幸翁,大谷良行:Furukawa-Sky Review, 7 (2011), 38-44.
- 33) L.F. Lin, C.Y. Chao and D.D. Macdonald: J. Electrochem. Soc., 128 (1981) 1194-1198.
- 34) T. Shimada, K. Fushimi, A.W. Hassel and H. Konno: Corros. Rev., **30** (2012), 199-207.
- 35) M.A. Blesa, A.E. Regazzoni and A.J. Maroto: Mater. Sci. Forum, **29** (1988), 31-98.

- 36) T.R. Beck : Electrochim. Acta, 30 (1985), 725-730.
- 37) Kemal Nisancioglu : Corrosion behavior and protection of copper and aluminium alloys in sea water, edited by D. Féron, Woodhead Publishing, (2007).
- 38) 興戸正純, 沖猛雄: 軽金属, 36 (1986), 416-420.
- 39) G. Sussek, M. Kesten and H.G. Feller: Metall, 33 (1979), 1031-1039.
- 40) G. Sussek, M. Kesten and H.G. Feller: Metall, 33 (1979), 1276-1281.
- S. Radhakrishnan, N. Sonawane and C.R. Siju: Prog. Org. Coat., 64 (2009), 383-386.
- 42) C.H. Hsu and F. Mansfeld: Corros., 57 (2001), 747-748.
- 43) S.C. Chung, S.L. Sung, C.C. Hsien and H.C. Shih: J. Appl. Electrochem., 30 (2000), 607-615.
- 44) Y.Y. Chen, S.C. Chung and H.C. Shih: Corros. Sci., 48 (2006), 3547-3564.
- 45) A.P. Yadav, A. Nishikata and T. Tsuru: Corros. Sci., 46 (2004), 169-181.
- 46) C. Liu, Q. Bi, A. Leyland and A. Matthews: Corros. Sci., 45 (2003), 1257-1273.
- 47)本川幸翁,水谷高大,兒島洋一,興戸正純:軽金属, 61 (2011), 383-388.
- 48) 永山政一, 高橋英明, 甲田 満:金属表面技術, 30 (1979), 438-456.
- 49) 甲田満, 高橋英明, 永山政一:金属表面技術, 33 (1982), 242-248.
- 50) 八重樫起郭,本川幸翁,加藤治,倉田正裕,兒島洋一:電 気化学会第81回大会講演要旨集,(2014),347.



島田 隆登志 (Takatoshi Shimada) (株) UACJ 技術開発研究所 深谷センター 第二部



 兒島 洋一 (Yoichi Kojima)
 (株) UACJ 技術開発研究所 深谷センター 第二部